

ГЕРМАНИЕВЫЕ МИКРОМОДУЛЬНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ М-ЗА-З—М-ЗД-З (*n-p-n*)

Конструктивное оформление — металлический герметизированный колпачок, устанавливаемый на микромодульной плате, с выводами, распаянными к пазам (см. рис. 233).

Вес 0,8 г.

Интервал рабочих температур от $+73$ до -60°C .

Допустимая относительная влажность окружающего воздуха 98% при температуре 40°C .

Интервал изменений атмосферного давления от 5 мм рт. ст. до 2 атм. Допускается применение транзисторов при атмосферном давлении до $1 \cdot 10^{-6}$ мм рт. ст.

Наибольшее постоянное ускорение 150 g.

Наибольшее ускорение при многократных ударах 150 g.

Наибольшее допустимое ускорение при вибрациях с частотами 5—2000 гц 10 g.

Микротранзисторы монтируются на микромодульных платах размером $9,6 \times 9,6 \times 3,1$ мм и обозначаются буквами ТМ или М. Электроды транзисторов распаяются по пазам микромодульной платы: 1 — база, 5 — эмиттер, 8 — коллектор.

Рабочее положение — любое.

Основное назначение — работа в аппаратуре различного назначения с микромодульным исполнением.

Параметры транзисторов приведены в табл. 122.

Таблица 122

Параметры	Тип транзистора				
	М-ЗА-З	М-ЗБ-З	М-ЗВ-З	М-ЗГ-З	М-ЗД-З
Предельная частота усиления по току, Мгц	1	1	5	5	10
Коэффициент усиления по току в схеме с общим эмиттером	18—55	40—120	25—75	60—180	60—250
Наибольшее напряжение на коллекторе в схеме с общей базой, в	+15	+15	+15	+15	+15
Наибольшая рассеиваемая мощность, мвт	75	75	75	75	75